

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2610346

Способ изготовления омических контактов к нитридным гетероструктурам AlGaIn/GaN

Патентообладатель: *Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук (ИСВЧПЭ РАН) (RU)*

Авторы: *Федоров Юрий Владимирович (RU), Павлов Александр Юрьевич (RU), Павлов Владимир Юрьевич (RU)*

Заявка № 2015154773

Приоритет изобретения 21 декабря 2015 г.

Дата государственной регистрации в

Государственном реестре изобретений

Российской Федерации 09 февраля 2017 г.

Срок действия исключительного права

на изобретение истекает 21 декабря 2035 г.

*Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности*

Г.П. Ивлиев

